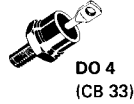


DO 27 (CB 197) DO 29 (CB 126)



DO 4 (CB 33)



CB 150 (TO 126)

Fast recovery silicon rectifier diodes – t_{rr} 300 ns
Diodes de redressement rapides au silicium – t_{rr} 300 ns

Type	Case Boîtier	V_{RRM} (V)	$T_{(vj)}$ (°C) max	I_O (A)	I_{FSM} (A) t_p 10 ms	V_F / I_F (V) (A) 25 °C max	I_R / V_{RRM} (mA) $T_{(vj)}$ 125 °C max	$t_{rr}^{(2)}$ (ns) max	DRT 76 Page
BA 157	DO29pl.	400	125	0,4 T_{amb} 50 °C	15	1,5 0,4	5(1)	300 (3)	#
BA 158	DO29pl.	600	125	0,4 T_{amb} 50 °C	15	1,5 0,4	5(1)	300 (3)	#
BA 159	DO29pl.	1000	125	0,4 T_{amb} 50 °C	15	1,5 0,4	5(1)	300 (3)	#
ESM 181-300 R	CB 150	300	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BYV 87-300 R	CB 150	300	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
ESM 181-400 R	CB 150	400	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BYV 87-400 R	CB 150	400	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
ESM 181-500 R	CB 150	500	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BYV 87-500 R	CB 150	500	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
ESM 181-600 R	CB 150	600	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BYV 87-600 R	CB 150	600	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
ESM 181-800 R	CB 150	800	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BYV 87-800 R	CB 150	800	125	4 T_{case} 100 °C	60	1,4 4	0,5	300	279
BY 212-250 R	DO 4	250	125	4 T_{case} 100 °C	70	1,4 4	0,5 (4)	300	229
BY 212-400 R	DO 4	400	125	4 T_{case} 100 °C	70	1,4 4	0,5 (4)	300	229
BY 212-500 R	DO 4	500	125	4 T_{case} 100 °C	70	1,4 4	0,5 (4)	300	229
BY 212-600 R	DO 4	600	125	4 T_{case} 100 °C	70	1,4 4	0,5 (4)	300	229
BY 212-750 R	DO 4	750	125	4 T_{case} 100 °C	70	1,4 4	0,5 (4)	300	229
ESM 182-50 R	CB 150	50	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289
ESM 182-100 R	CB 150	100	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289
ESM 182-200 R	CB 150	200	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289
ESM 182-400 R	CB 150	400	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289
ESM 182-600 R	CB 150	600	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289
ESM 182-800 R	CB 150	800	150	8 T_{case} 85 °C	100	1,4 8	0,5	300	289

Fast recovery silicon rectifier diodes – t_{rr} 500 ns
Diodes de redressement rapides au silicium – t_{rr} 500 ns

BY 296	DO27pl.	100	150	2 T_{amb} 50 °C	70	1,3 3	10(1)	500(5)	#
BY 297	DO 27pl.	200	150	2 T_{amb} 50 °C	70	1,3 3	10(1)	500(5)	#
BY 298	DO27pl.	400	150	2 T_{amb} 50 °C	70	1,3 3	10(1)	500(5)	#
BY 299	DO27pl.	800	150	2 T_{amb} 50 °C	70	1,3 3	10(1)	500(5)	#

- (1) T_{amb} 25 °C
 (2) I_F 1 A, V_R 30 V, dI_F/dt 15 A/ μ s, $T_{(vj)}$ 25 °C
 (3) I_F 2 mA, I_R 2 mA, I_{rr} 0,2 mA
 (4) $T_{(vj)}$ 100 °C
 (5) I_F 10 mA, I_R 10 mA, I_{rr} 1 mA

To be published later
Sera publiée ultérieurement